

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 29 年 6 月 22 日 (2017.6.22)

【公開番号】特開 2015-35415 (P2015-35415A)

【公開日】平成 27 年 2 月 19 日 (2015.2.19)

【年通号数】公開・登録公報 2015-011

【出願番号】特願 2014-95629 (P2014-95629)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/12 (2006.01)

H 0 5 B 33/26 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/12 E

H 0 5 B 33/26 Z

H 0 5 B 33/12 B

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 6 5

G 0 9 F 9/30 3 4 9 B

G 0 9 F 9/30 3 4 9 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 5 月 8 日 (2017.5.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

前記ベース層が前記高分子物質を含む場合、前記高分子物質はポリイミド (polyimide)、ポリカーボネート (polycarbonate)、ポリエチレンテレフタレート (PET: polyethyleneterephthalate)、ポリウレタン (polyurethane)、ポリアクリロニトリル (PAN: polyacrylonitril)、ポリエチレン (PE: polyethylene)、及びポリプロピレン (PP: polypropylene) のうち、いずれか一つを含むことを特徴とする請求項 2 に記載の表示パネル。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記第 1 画素電極の光反射率は 100%であることを特徴とする請求項 1 に記載の表示パネル。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 8】

前記低温ポリシリコンは 100 度 (C e l s i u s d e g r e e) 以下の工程で形成されることを特徴とする請求項 7 に記載の表示パネルの製造方法。